

L, S 波段中功率单刀双掷开关

XA2179

概述

XA2179 是用于手机和其他 L, S 波段应用的 GaAs MMIC L, S 波段单刀双掷开关；芯片可在 2.5V–5.3V 的两路控制电压下工作；并在 0.05–3.0GHz 的范围内工作，具有低插入损耗和高隔离度；该通用开关可以用于各种电信应用。

XA2179 器件采用 6 引脚超小型封装，适合于高密度表面贴片。

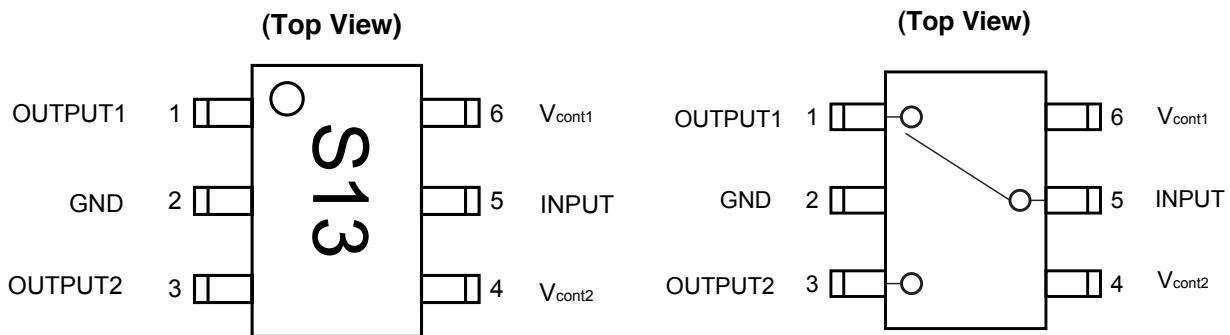
产品特点

- 开关控制电压 : V_{cont} (H) = 2.5 to 5.3 V (3.0 V TYP.)
: V_{cont} (L) = -0.2 to +0.2 V (0 V TYP.)
- 低插入损耗 : Lins1 = 0.25 dB TYP. @ f = 0.05 to 1.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
: Lins2 = 0.30 dB TYP. @ f = 1.0 to 2.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
: Lins3 = 0.35 dB TYP. @ f = 2.0 to 2.5 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
: Lins4 = 0.40 dB TYP. @ f = 2.5 to 3.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
- 高隔离 : ISL1 = 27 dB TYP. @ f = 0.05 to 2.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
: ISL2 = 24 dB TYP. @ f = 2.0 to 3.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
- 功率容量 : Pin (0.1 dB) = +29.0 dBm TYP. @ f = 0.5 to 3.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
: Pin (1 dB) = +32.0 dBm TYP. @ f = 0.5 to 3.0 GHz, V_{cont} (H) = 3.0 V, V_{cont} (L) = 0 V
- 封装形式 : 6-pin 超小尺寸封装 (2.0 × 1.25 × 0.9 mm)

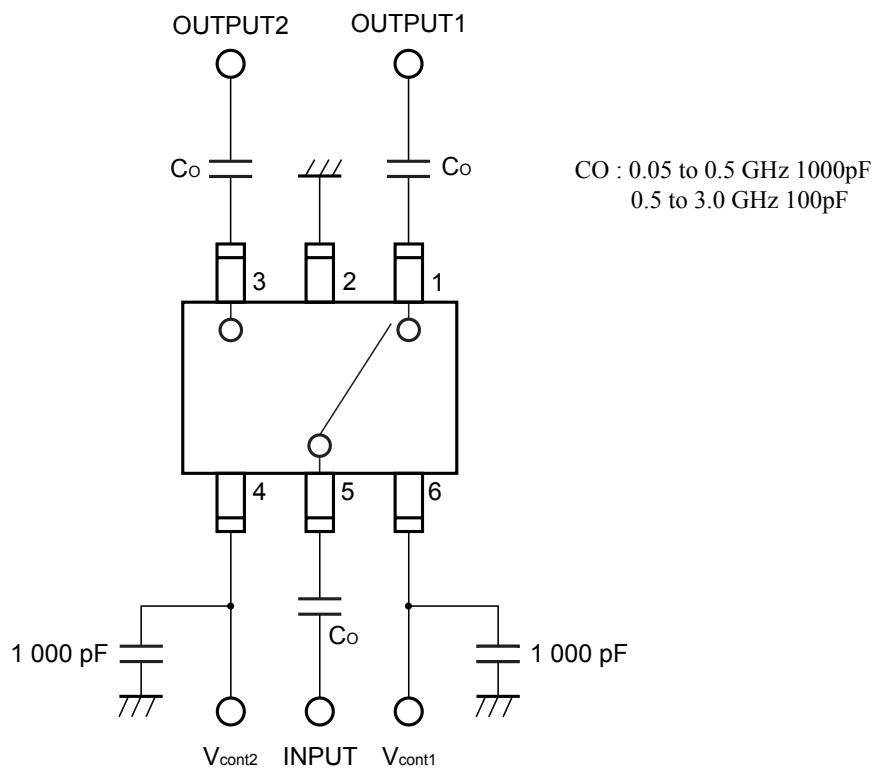
应用领域

- 手机, L,S 数字蜂窝系统
- W-LAN, 蓝牙设备

引脚示意图



应用电路图



真值表 (电平电压: 高: 2.5V~5.3V, 低: -0.2V~0.2V)

V _{cont1}	V _{cont2}	INPUT-OUTPUT1	INPUT-OUTPUT2
低	高	开	关
高	低	关	开

电性能参数

($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{\text{cont(H)}} = 3.0 \text{ V}$, $V_{\text{cont(L)}} = 0 \text{ V}$, DC隔离电容 = 100 pF)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Insertion Loss 1	L_{ins1}	$f = 0.05 \text{ to } 1.0 \text{ GHz}$ ^{Note1}	—	0.25	0.45	dB
Insertion Loss 2	L_{ins2}	$f = 1.0 \text{ to } 2.0 \text{ GHz}$	—	0.30	0.50	dB
Insertion Loss 3	L_{ins3}	$f = 2.0 \text{ to } 2.5 \text{ GHz}$	—	0.35	0.55	dB
Insertion Loss 4	L_{ins4}	$f = 2.5 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$	—	0.40	0.60	dB
Isolation 1	ISL1	$f = 0.05 \text{ to } 2.0 \text{ GHz}$ ^{Note1}	23	27	—	dB
Isolation 2	ISL2	$f = 2.0 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$	20	24	—	dB
Input Return Loss	RL_{in}	$f = 0.05 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$ ^{Note1}	15	20	—	dB
Output Return Loss	RL_{out}	$f = 0.05 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$ ^{Note1}	15	20	—	dB
0.1 dB Loss Compression	$P_{\text{in}}(0.1 \text{ dB})$	$f = 2.0 \text{ GHz}$	+25.5	+29.0	—	dBm
Input Power ^{Note2}		$f = 2.5 \text{ GHz}$	+25.5	+29.0	—	dBm
		$f = 0.5 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$	—	+29.0	—	dBm
Switch Control Current	I_{cont}	No signal	—	4	20	μA
Switch Control Speed	t_{sw}	50%CTL to 90/10%RF	—	50	500	ns

备注 1. DC 隔离电容 = 1 000 pF at $f = 0.05 \text{ to } 0.5 \text{ GHz}$.

2. $P_{\text{in}}(0.1 \text{ dB})$ 是插入损耗比线性范围增加0.1dB时测得的输入功率

标准参考特性

($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{\text{cont(H)}} = 3.0 \text{ V}$, $V_{\text{cont(L)}} = 0 \text{ V}$, DC 隔直电容= 100 pF)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1 dB Loss Compression Input Power	$P_{\text{in}}(1 \text{ dB})$	$f = 0.5 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$	—	+32.0	—	dBm
3rd Order Intermodulation Intercept Point	IIP_3	$f = 0.5 \text{ to } 3.0 \text{ GHz}$, 2 tone, 5 MHz spicing	—	+60.0	—	dBm

注意事项

使用该IC时，必须在II0引脚外部连接一个直流耦合电容器。

当使用0.5 GHz或更高的频率时，建议使用一个电容为100 pF或更低的直流耦合电容器；

当使用一个小于0.5 GHz的频率时，建议使用一个电容为1000 pF的电容器。

实际值需根据使用的频率和带宽而变化，因此请根据使用条件选择具有合适电容的电容器。

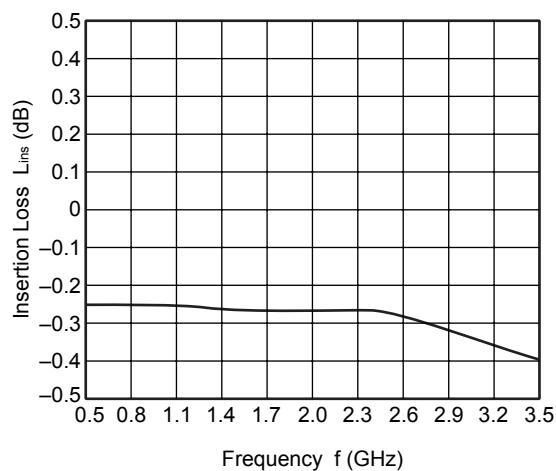
极限参数

参数	符号	范围	单位
开关控制电压	V_{cont}	6.0	V
输入功率	P_{in}	+33	dBm
工作环境温度	T_A	-45 to +85	°C
储存温度	T_{stg}	-55 to +150	°C

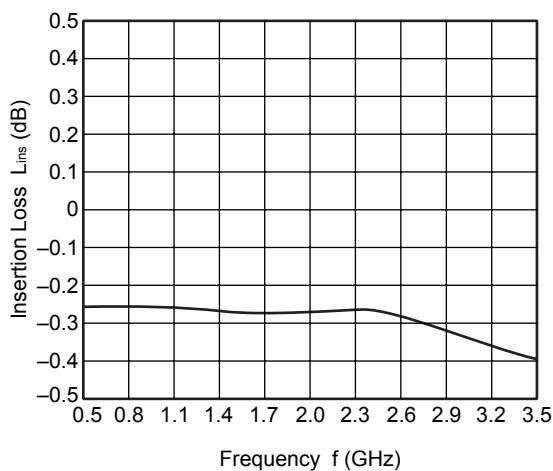
典型特征

($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{\text{cont(H)}} = 3.0 \text{ V}$, $V_{\text{cont(L)}} = 0 \text{ V}$, DC隔离电容 = 100 pF)

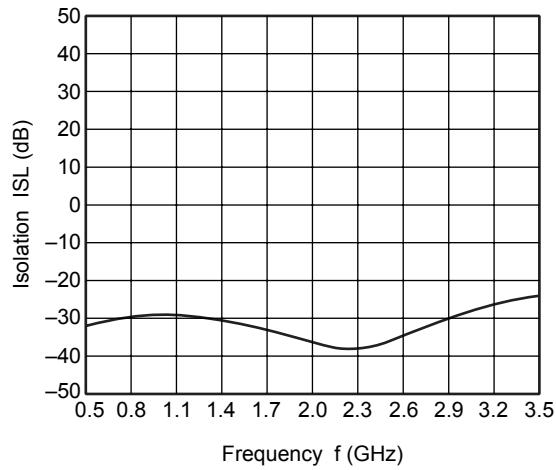
INPUT-OUTPUT1
INSERTION LOSS vs. FREQUENCY



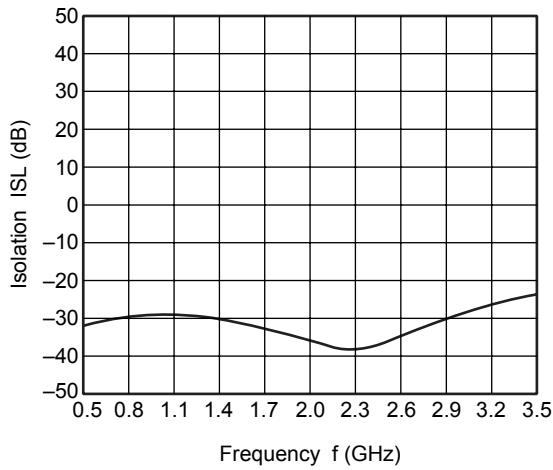
INPUT-OUTPUT2
INSERTION LOSS vs. FREQUENCY



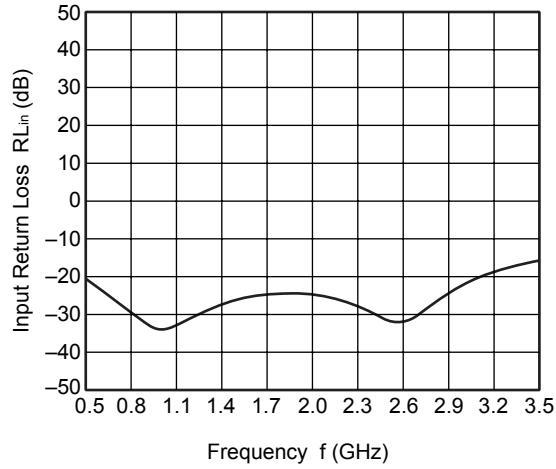
INPUT-OUTPUT1
ISOLATION vs. FREQUENCY



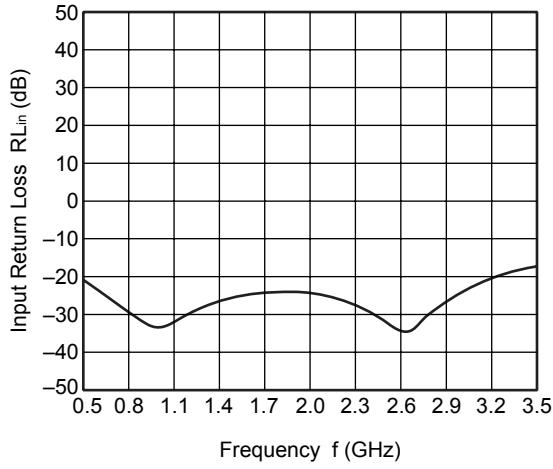
INPUT-OUTPUT2
ISOLATION vs. FREQUENCY

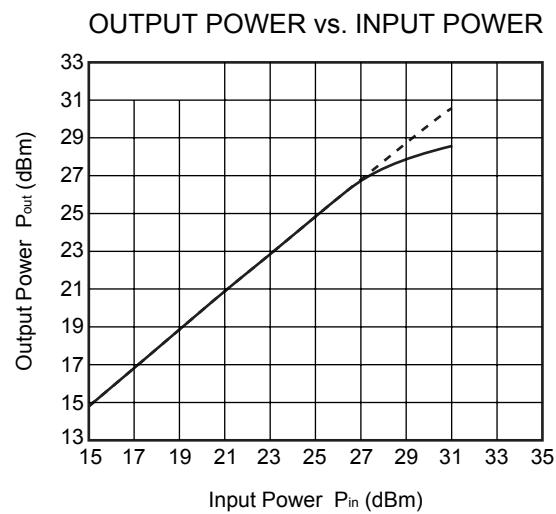
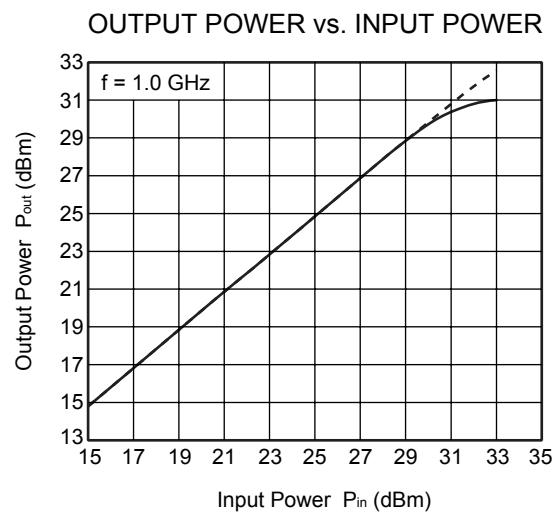
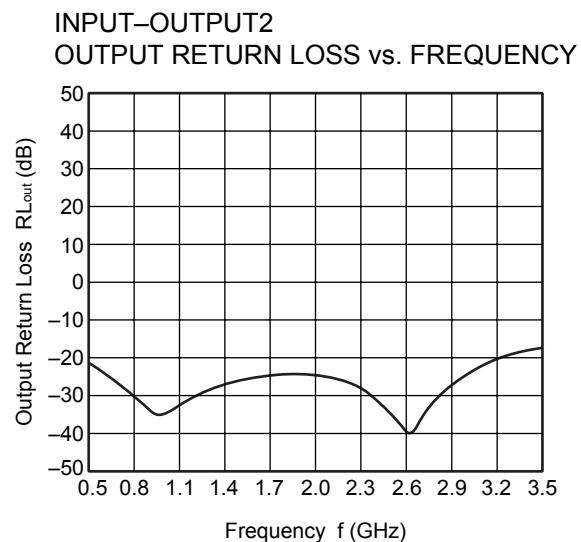
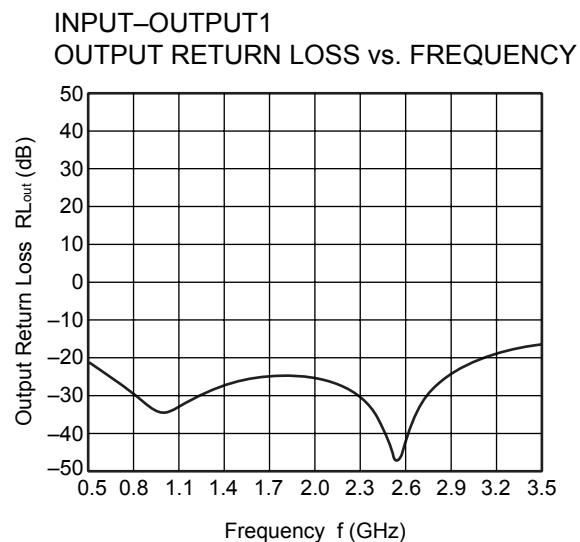


INPUT-OUTPUT1
INPUT RETURN LOSS vs. FREQUENCY

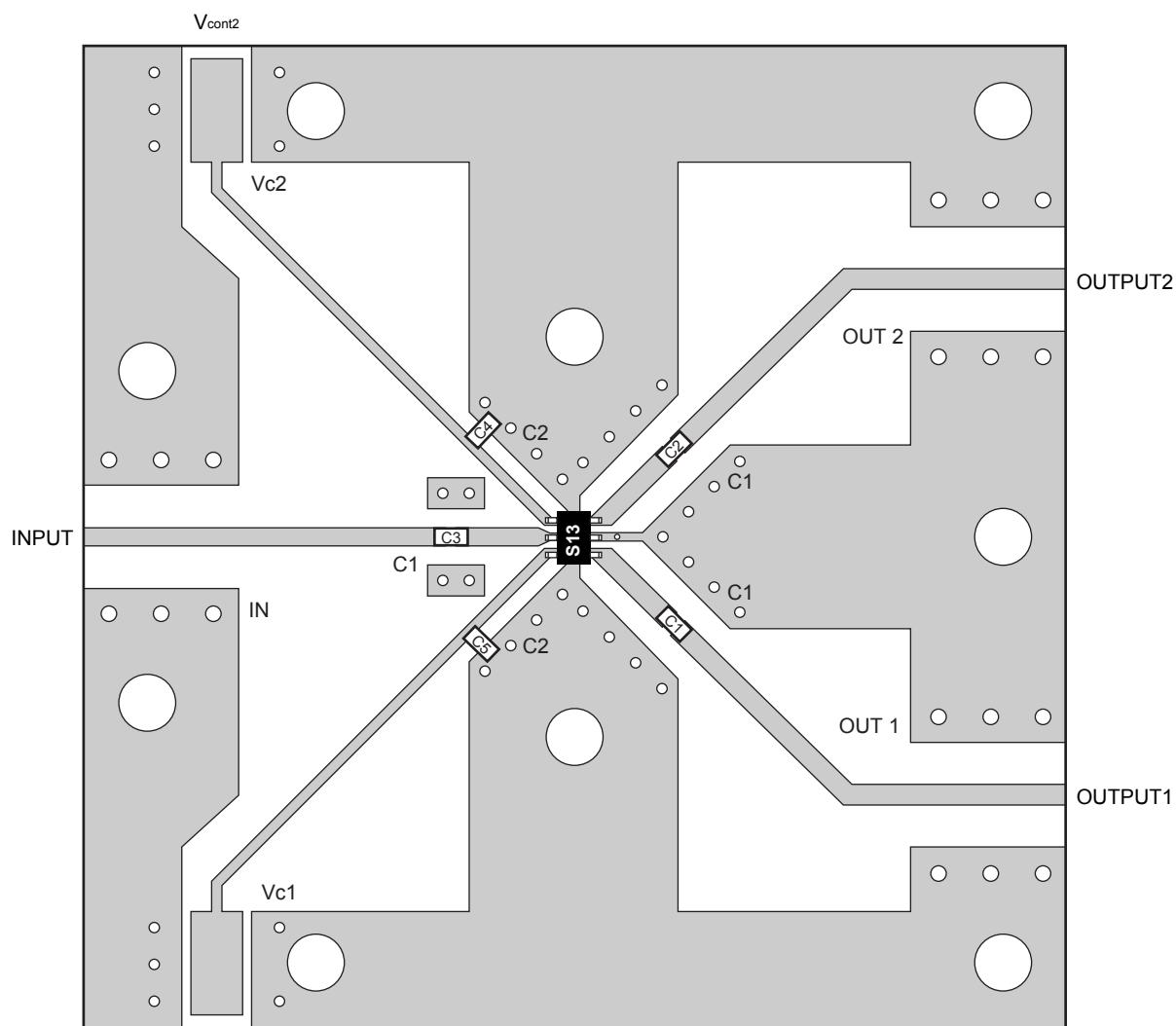


INPUT-OUTPUT2
INPUT RETURN LOSS vs. FREQUENCY



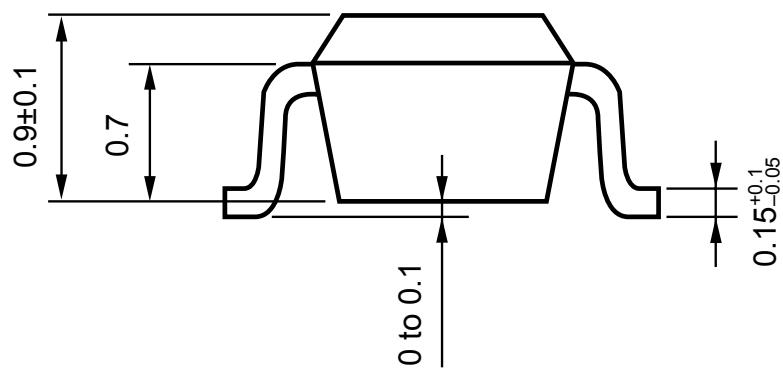
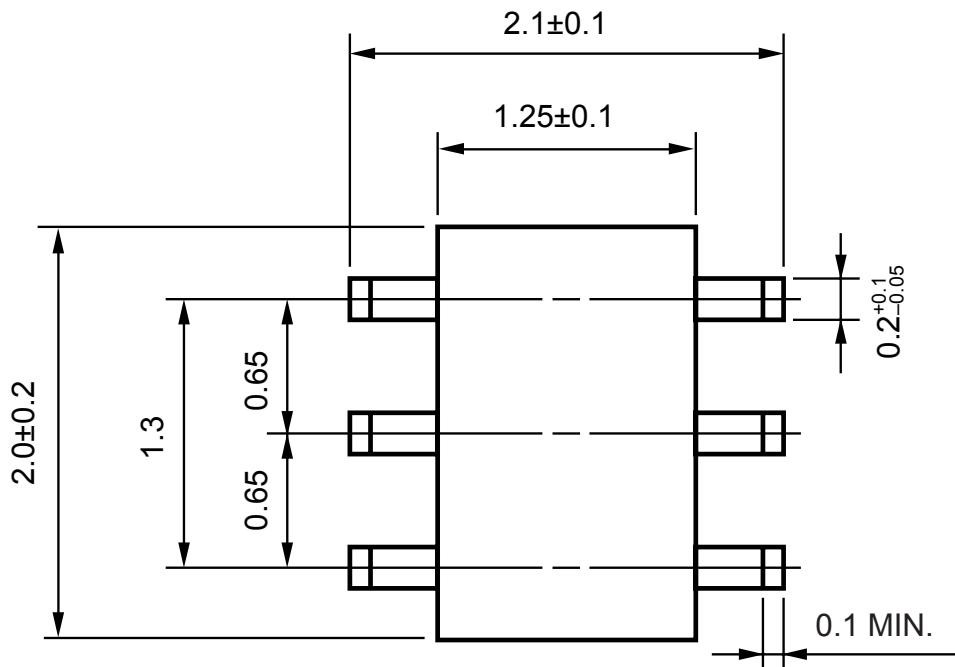


评估板 LAYOUT



封装信息

6-PIN SMM (UNIT: mm)



以上信息仅供参考. 如需帮助联系客服人员。谢谢 XINLUDA